



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, Министерство энергетики Республики Узбекистан, Академия наук Республики Узбекистан, Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете Узбекистана, Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Ташкенте и Ташкентский государственный технический университет 26-27 сентября 2024 г. проводят совместно III Международную научную конференцию «**Современные тенденции развития физики полупроводников: достижения, проблемы и перспективы**».

Цель конференции: повышение качества научно-исследовательских работ, проводимых учеными-физиками Республики Узбекистан и содействие внедрению результатов в производство, а также установление научных контактов между отечественными и зарубежными учеными.

В связи с этим, просим вас направлять тезисы докладов в электронном виде на узбекском, русском или английском языках через официальный сайт конференции (<https://journal.ispm.uz/conference/Anketa.html>) до 10 сентября 2024 года.

На конференцию представляются работы по следующим направлениям:

- Секция 1:** Теоретические и экспериментальные проблемы физики полупроводников.
- Секция 2:** Материалы полупроводниковой опто-, микро- и нанoeлектроники, технологии и компоненты.
- Секция 3:** Создание высокоэффективных технологий использования альтернативных источников энергии и их развитие.
- Секция 4:** Перспективы развития традиционной энергетики.
- Секция 5:** Взгляд молодых ученых на актуальные проблемы физики.

Требования к оформлению тезисов докладов указаны в Приложении.

Публикация тезисов бесплатная. Участники конференции, выступившие с докладом, получают электронный сертификат. Сборник материалов конференции будет доступен для скачивания с официального сайта НИИ физики полупроводников и микроэлектроники (www.ispm.uz) после проведения конференции.

По итогам конференции самые лучшие доклады будут опубликованы в виде статьи в научном журнале «Физика полупроводников и микроэлектроника» в соответствии с его требованиями.

Конференция начнется в 10:00 26 сентября 2024 г. Онлайн-формат будет реализован через платформу «Zoom». Ссылка на «Zoom» будет отправлена на адрес электронной почты, указанный участниками при регистрации.

Подробная информация о конференции доступна на сайте: www.ispm.uz.

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС

100057, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Янги Алмазар, 20.

НИИ физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете Узбекистана
Телефон для справок: (+998) 91 1341901 (Н.А. Тургунов), (+998) 97 2550805 (К.М. Файзуллаев)



ПРИЛОЖЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Текст тезисов доклада должен быть написан шрифтом Times New Roman, 14 кегль, с межстрочным интервалом 1,15. Объем тезисов не должен превышать 3-х страниц формата А4 (210×297 мм) с полями:

сверху – 20 мм; слева – 30 мм;
снизу – 20 мм; справа – 15 мм.

Название тезисов доклада печатается прописными (заглавными) буквами полужирным шрифтом. Добавив интервал после абзаца названия, полужирным шрифтом печатаются инициалы и фамилия авторов (Ф.И.О. докладчика подчеркивается).

Со следующей строки основным шрифтом печатается для каждого из авторов название организации с указанием города и страны.

Название тезисов доклада, инициалы и фамилия авторов, информация об организации выравниваются по центру.

Через интервал после последней строки основным шрифтом печатается текст тезисов доклада. Основной текст следует выравнивать по ширине, оставив в первой строке абзаца отступ в 1 см.

Добавив интервал после основного текста приводится список литературы по следующему образцу:

Список использованной литературы

(для статей)

[1] И.О. Фамилия(-и). *Название статьи. Название журнала. (Год), Номер (или Том (Номер)), с. 1-10.*

(для книг)

[2] И.О. Фамилия(-и). *Название книги. (Город, Издательство, год)*